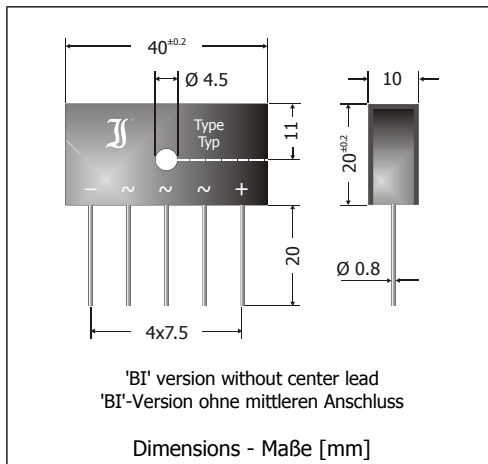


BI6-8 ... BI6-12, DBI6-8 ... DBI6-12
**Single/Three-Phase Si-Bridge-Rectifiers
Ein-/Dreiphasen-Si-Brückengleichrichter**

Version 2013-10-02



| | |
|--|-------------------|
| Nominal current Nennstrom | 6 A |
| Alternating input voltage Eingangswchelsspannung | 560, 800 V |
| Metal case Metallgehäuse | 40 x 20 x 10 [mm] |
| Weight approx. – Gewicht ca. | 35 g |
| Compound has classification UL94V-0 Vergussmasse nach UL94V-0 klassifiziert | |
| Standard packaging bulk Standard Lieferform lose im Karton | |



Recognized Product – Underwriters Laboratories Inc.® File E175067
Anerkanntes Produkt – Underwriters Laboratories Inc.® Nr. E175067

Maximum ratings
Grenzwerte

| Type Typ ¹⁾ | Max. alternating input voltage Max. Eingangswchelsspannung V_{VRMS} [V] | Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzenspersspannung V_{RRM} [V] ²⁾ |
|---------------------------|---|--|
| BI6-8 | 1~ | 560 |
| DBI6-8 | 3~ | 560 |
| BI6-12 | 1~ | 800 |
| DBI6-12 | 3~ | 800 |

| | | | |
|--|--------------------------|----------------|------------------------------|
| Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom | $f > 15$ Hz | I_{FRM} | 30 A ³⁾ |
| Peak forward surge current 50 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwell | $T_A = 25^\circ\text{C}$ | I_{FSM} | 125 A |
| Peak forward surge current 60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 60 Hz Sinus-Halbwell | $T_A = 25^\circ\text{C}$ | I_{FSM} | 135 A |
| Rating for fusing, $t < 10$ ms Grenzlastintegral, $t < 10$ ms | $T_A = 25^\circ\text{C}$ | i^2t | 78 A ² s |
| Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur | | T_j T_s | -50...+150°C -50...+150°C |

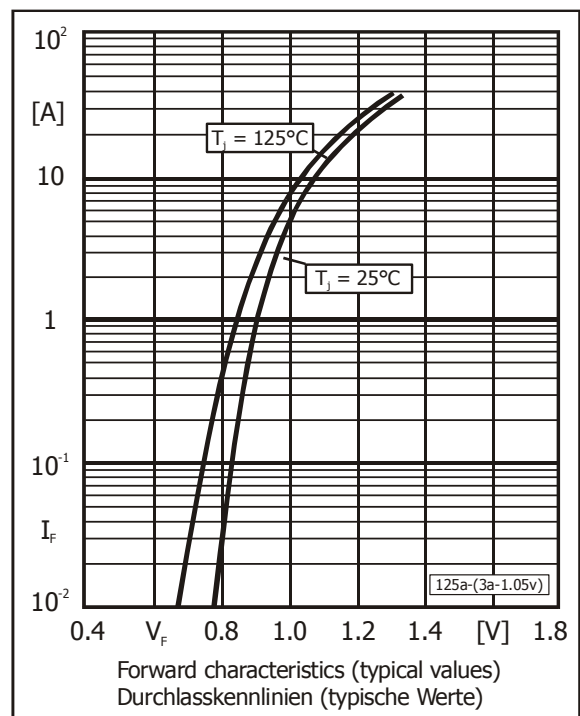
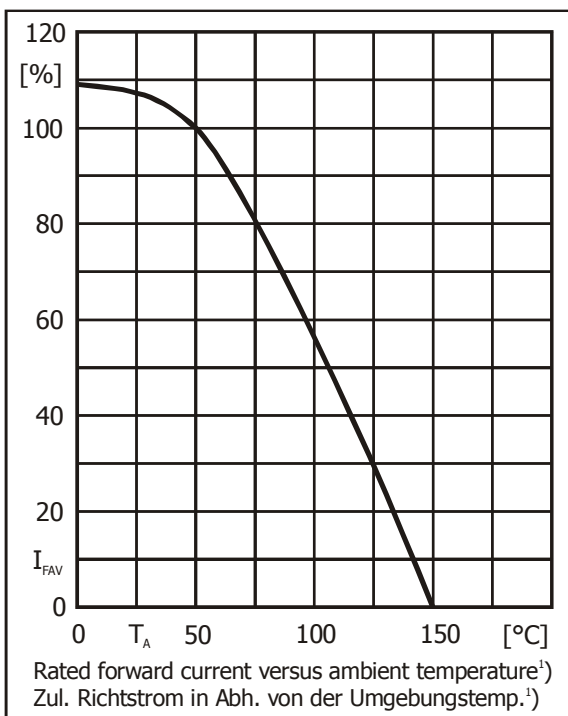
1 'BI' designates the single phase version, 'DBI' the three phase version
'BI' bezeichnet die Einphasen-Version, 'DBI' die Dreiphasen-Version

2 Valid per diode – Gültig pro Diode

3 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 5 mm from case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 5 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

Characteristics
Kennwerte

| | | | |
|--|---|-----------|---------------------------------------|
| Max. current without cooling fin Dauergrenzstrom ohne Kühlblech | $T_A = 50^\circ\text{C}$ | I_{FAV} | 2.0 A |
| Max. current with cooling fin 300 cm ² Dauergrenzstrom mit Kühlblech 300 cm ² | $T_A = 50^\circ\text{C}$ | I_{FAV} | 6 A |
| Forward voltage Durchlass-Spannung | $T_j = 25^\circ\text{C}$ $I_F = 3\text{ A}$ | V_F | < 1.05 V ⁴⁾ |
| Leakage current – Sperrstrom | $T_j = 25^\circ\text{C}$ $V_R = V_{RRM}$ | I_R | < 10 μA |
| Isolation voltage terminals to case Isolationsspannung Anschlüsse zum Gehäuse | | V_{ISO} | > 2500 V |
| Thermal resistance junction to case Wärmewiderstand Sperrschicht – Gehäuse | | R_{thc} | < 4 K/W |
| Admissible torque for mounting Zulässiges Anzugsdrehmoment | | M4 | 18 \pm 10% lb.in. 2 \pm 10% Nm |



4 Valid for one diode – Gültig pro Diode